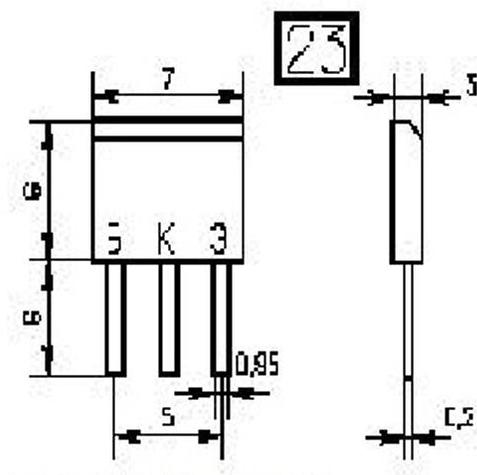


ТИП	B1-B2/Iк /мА	Fт МГц	Ск/Ук пф/В	Сэ/Уэб пф/В	Rб*Ск псек	tr нс	Укэ/(Iк/Iб) В/(мА/мА)	Iкo мкА	Укб В	Укэ/R В/кОм	Уэб В	Iкм/Iкн мА/мА	Рк мВт	Пер	Цок
КТ315А	20- 90/1	250	7/10		300		0.4/(20/2 )	1	25	20/10	6	100/	150	N-P-N	23
КТ315Б	50-350/1	250	7/10		300		0.4/(20/2 )	1	20	15/10	6	100/	150	N-P-N	23
КТ315В	20- 90/1	250	7/10		500		0.4/(20/2 )	1	40	30/10	6	100/	150	N-P-N	23
КТ315Г	50-350/1	250	7/10		500		0.4/(20/2 )	1	35	25/10	6	100/	150	N-P-N	23
КТ315Д	20- 90/1	250	7/10		1000		1.0/(20/2 )	1	40	40/10	6	100/	150	N-P-N	23
КТ315Е	50-350/1	250	7/10		1000		1.0/(20/2 )	1	35	35/10	6	100/	150	N-P-N	23
КТ315Ж	30-250/1	250	10/10		-		0.5/(20/2 )	10	-	15/10	6	50/	100	N-P-N	23
КТ315И	30- /	150	/		-		-	100	-	60/10	6	50/	100	N-P-N	23
КТ315Р	150-350/	250	/		-		0.4/(20/2 )	0.5	35	35/10	6	100/	150	N-P-N	23

Обозначение	Параметр
B1-B2/Iк	статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером; в справочнике приводятся минимальное (B1) и максимальное (B2) значение и ток (Iк) при котором этот параметр определяется.
Fт	предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора.
Ск/Ук	емкость коллекторного перехода (Ск) и напряжение на коллекторе (Ук), при котором она измеряется.
Сэ/Уэ	емкость эмиттерного перехода (Сэ) и напряжение эмиттер/база (Уэ), при котором она измеряется.
Rб*Ск	постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте биполярного транзистора.
tr	время рассасывания биполярного транзистора.
Укэ(Iк/Iб)	напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Укэ) биполярного транзистора при заданном токе коллектора (Iк) и заданном токе базы (Iб).
Iкo	обратный ток коллектора.
Укб	максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база.
Уэб	максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база.
Укэ/R	максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Укэ) при заданной величине сопротивления, включенного между базой и эмиттером (R).
Iбм	предельно допустимый постоянный ток базы транзистора.
Iкм/Iкнас	предельно допустимый постоянный (Iкм) ток коллектора предельно допустимый ток коллектора в режиме насыщения (Iкнас) или в импульсе.
Рк	максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на коллекторе.
Рк/Рт	максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на транзисторе без теплоотвода (Рк) и с теплоотводом (Рт).
Рпк	тепловое сопротивление перехода коллектор-корпус транзистора.
Пер	тип перехода транзистора.
Цок	номер рисунка с расположением выводов.



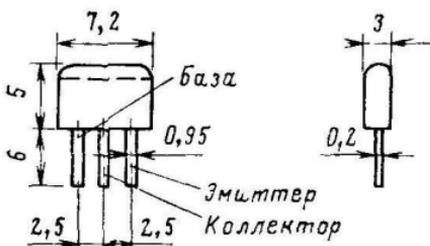
Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение.

Значение со звездочкой (\*) приводится для импульсного режима.

Параметр, помеченный буквой "т" означает, что приводится типовое значение.

**КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,  
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* уси-  
тельные высокочастотные маломощные.



Предназначены для работы в схемах усилителей высокой, промежуточной и низкой частоты

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на этикетке

Масса транзистора не более 0,18 г

### Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_{\text{Э}} = 5$ мА не менее	
КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж . . . . .	15 В
КТ315В, КТ315Д, КТ315И . . . . .	30 В
КТ315Г, КТ315Е . . . . .	25 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{\text{К}} = 20$ мА, $I_{\text{Б}} = 2$ мА не более	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г . . . . .	0,4 В
КТ315Д, КТ315Е . . . . .	1 В
КТ315Ж . . . . .	0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{\text{К}} = 20$ мА, $I_{\text{Б}} = 2$ мА не более	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г . . . . .	1,1 В
КТ315Д, КТ315Е . . . . .	1,5 В
КТ315Ж . . . . .	0,9 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{\text{КЭ}} = 10$ В, $I_{\text{К}} = 1$ мА	
КТ315А, КТ315Б, КТ315Д . . . . .	20 — 90
КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е . . . . .	50 — 350
КТ315Ж . . . . .	30 — 250
КТ315И не менее . . . . .	30
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{\text{КБ}} = 10$ В, $I_{\text{Э}} = 5$ мА не более	
КТ315А . . . . .	300 нс
КТ315Б, КТ315В, КТ315Г . . . . .	500 нс
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж . . . . .	1000 нс
Модуль коэффициента передачи тока при $U_{\text{КЭ}} = 10$ В, $I_{\text{К}} = 1$ мА, $f = 100$ МГц не менее	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315И . . . . .	2,5
КТ315Ж . . . . .	1,5
Емкость коллекторного перехода при $U_{\text{КБ}} = 10$ В не более	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315И . . . . .	7 пФ
КТ315Ж . . . . .	10 пФ
Входное сопротивление при $U_{\text{КЭ}} = 10$ В, $I_{\text{К}} = 1$ мА не менее . . . . .	
	40 Ом

Выходная проводимость при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 1$ мА не более . . . . .	0,3 мкСм
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В не бо- лее . . . . .	1 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм, $U_{КЭ} =$ $= U_{КЭ \text{ макс}}$ не более	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е. . . . .	1 мкА
КТ315Ж . . . . .	10 мкА
КТ315И . . . . .	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В не бо тее	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е,	
КТ315Ж . . . . .	30 мкА
КТ315И . . . . .	50 мкА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм	
КТ315А . . . . .	25 В
КТ315Б . . . . .	20 В
КТ315В, КТ315Д . . . . .	40 В
КТ315Г, КТ315Е . . . . .	35 В
КТ315Ж . . . . .	15 В
КТ315И . . . . .	60 В
Постоянное напряжение база-эмиттер . . . . .	6 В
Постоянный ток коллектора	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е . . . . .	100 мА
КТ315Ж, КТ315И . . . . .	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 213 - 298$ К	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е . . . . .	150 мВт
КТ315Ж, КТ315И . . . . .	100 мВт
Температура перехода . . . . .	393 К
Температура окружающей среды . . . . .	От 213 до 373 К

Примечания 1 Постоянная рассеиваемая мощность коллекто-  
ра, мВт, при  $T = 298 - 373$  К определяется по формуле

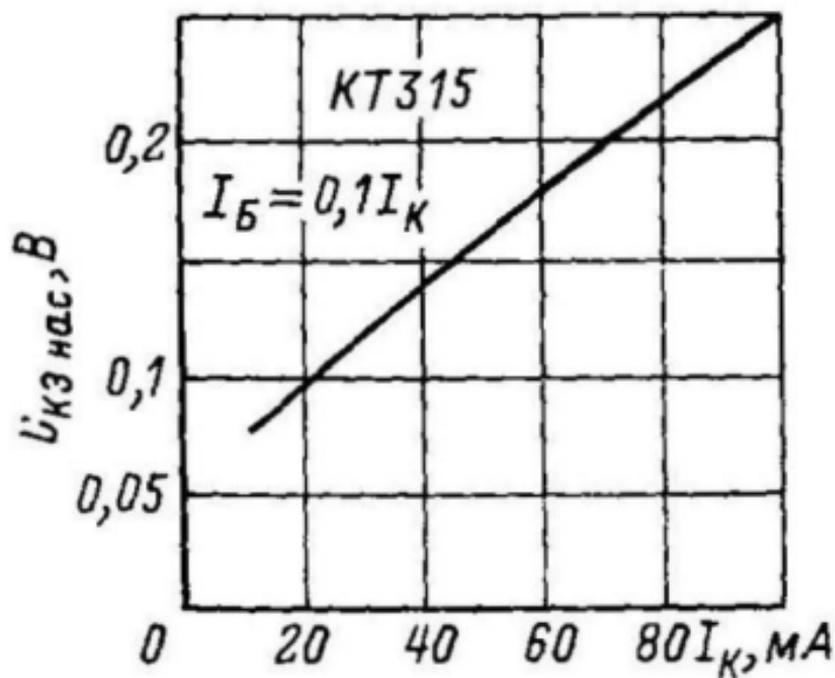
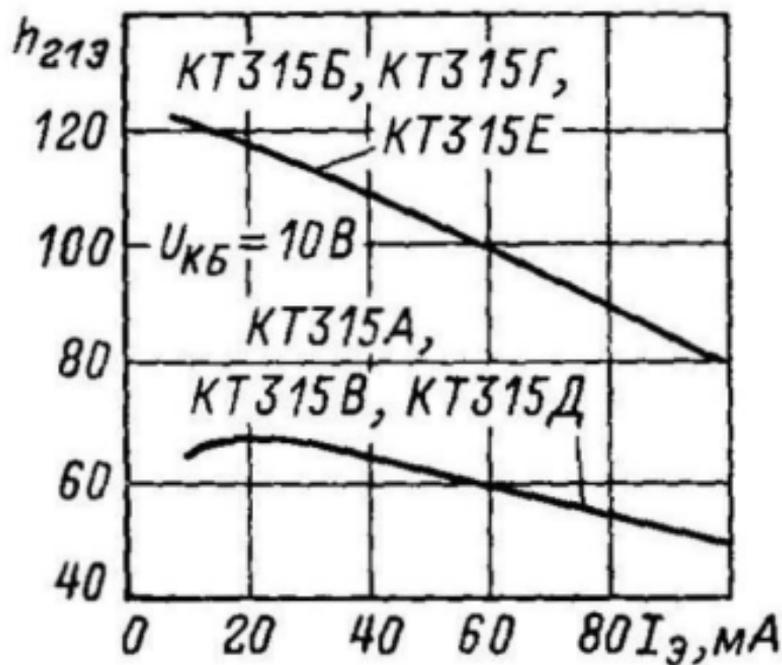
$$P_{К \text{ макс}} = (393 - T)/0,67$$

Допускается эксплуатация транзисторов в режиме  $P_K = 250$  мВт  
при  $U_{КБ} = 12,5$  В,  $I_K = 20$  мА

2 Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 2 мм  
от корпуса транзистора

При включении транзистора в схему, находящуюся под напря-  
жением, базовый вывод должен подсоединяться первым и отсоеди-  
няться последним

Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах,  
соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем интер-  
вале температур



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера

Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока базы

